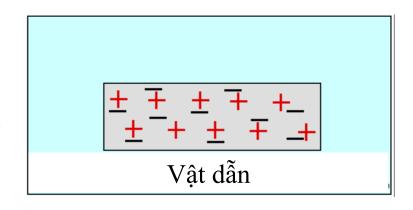
CHƯƠNG 2 - VẬT DẪN

- 1. Vật dẫn cân bằng tĩnh điện
- 2. Điện hưởng và tụ điện
- 3. Năng lượng điện trường

Vật dẫn (vật liệu dẫn điện)

Vật liệu có sẵn các điện tích tự do mà có thể dễ dàng di chuyển từ nguyên tử (phân tử) này tới nguyên tử (phân tử) khác ⇒ quá trình tái phân bố điện tích trên toàn bộ bề mặt khi bị nhiễm điện.



Ví dụ: Kim loại, than chì, các dung dịch muối, nước, cơ thể sống...

Chất bán dẫn (vật liệu bán dẫn)

- Vật liệu mà các điện tích tự do định xứ tại những vùng nhất định có thể tự do di chuyển khi chịu các tác động từ bên ngoài (ánh sáng, nhiệt độ...).
- ♦ Ví dụ: Si-líc, Germanium...

Phân loại vật liệu theo độ dẫn (khả năng dẫn điện)

| 1888 | 02000000 | 8666500 | N N N N N N N N N N N N N N N N N N N | w. (f | Độ d | ẫn | 00000000 | erye. | | Sexual | | |
|---------------|-----------|------------------|---------------------------------------|--------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----|---|------|-----|
| Chất điện môi | | | | Chất bán dẫn | | Vật dẫn | | | | | | |
| Cao su | Thủy tinh | G ₀ × | Kh/khí khô | Si-líc | Ger-ma-ni | Nước | Than chì | Thủy ngân | Sät | Nhôm | Đồng | Bạc |

Vật dẫn kim loại

- Diện tích tự do chính là các điện tử (electron) hóa trị do liên kết yếu với hạt nhân nguyên tử mà dễ dàng bị bứt khỏi nguyên tử và trở thành điện tử tự do.
- Vật dẫn cân bằng tĩnh điện: vật có các điện tích tự do đứng yên.

Điều kiện vật dẫn cân bằng tĩnh điện

Không có quá trình dịch chuyển điện tích và vector cường độ điện trường bên trong vật dẫn (khối hoặc rỗng):

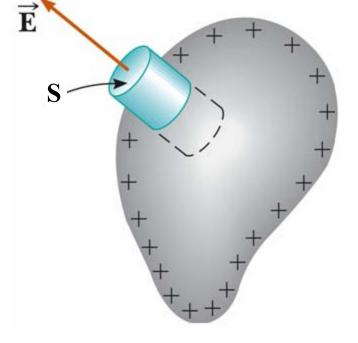
$$\vec{E}_{trong} = 0$$

Tại ∀ điểm trên bề mặt vật dẫn

$$E_t = 0$$

$$E_t = 0$$

$$E_n = E = \frac{\sigma}{\varepsilon \varepsilon_0}$$



➡ Đường sức điện trường vuông góc với bề mặt vật dẫn tại ∀ điểm

Tính chất của vật dẫn cân bằng tĩnh điện

Vật dẫn là vật đẳng thế

- - ➡ Hiệu điện thế giữa M & N,

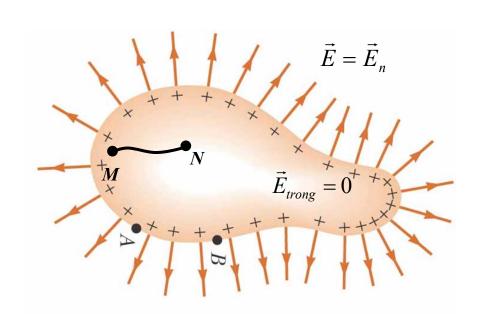
$$V_M - V_N = \int_M^N \vec{E} \, d\vec{S}$$

do
$$E = 0 \Rightarrow V_M - V_N = 0$$

$$V_M = V_N = V_A = V_B$$



$$\vec{E} = \vec{E}_n \Rightarrow E \perp \text{mặt đẳng thế tại mọi điểm}$$



Tính chất của vật dẫn cân bằng tĩnh điện

Điện tích chỉ phân bố trên bề mặt

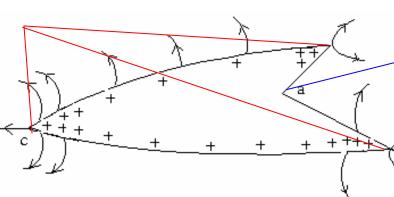
Bên trong vật dẫn, áp dụng định lý Gauss

$$\varepsilon \varepsilon_0 \oint \vec{E} \, \vec{dS} = \sum_i q_i \text{ do } E = 0 \Rightarrow \sum_i q_i = 0$$

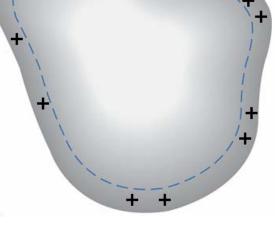
5 Điện tích tập trung trên bề mặt vật dẫn

Phân bố điện tích phụ thuộc hình dạng bề mặt

Diện tích tập trung chủ yếu tại các bề mặt lồi hoặc mũi nhọn



Không có điện tích ở bề mặt lõm hoặc hốc



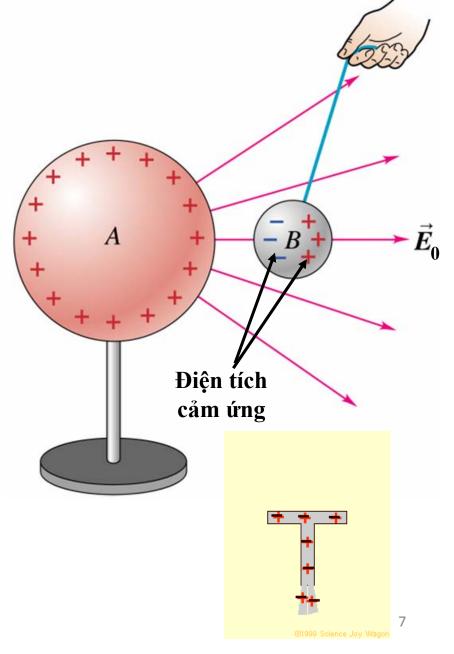
Măt Gauss

Hiện tượng điện hưởng

Lực hút tĩnh điện \Rightarrow các điện tử (electron) dịch chuyển ngược chiều E_0 về phía bề mặt gần $A \Rightarrow$ tích điện (-), phía đối diện tích điện (+).

 $\begin{align*} & \begin{subarray}{ll} \begin{suba$

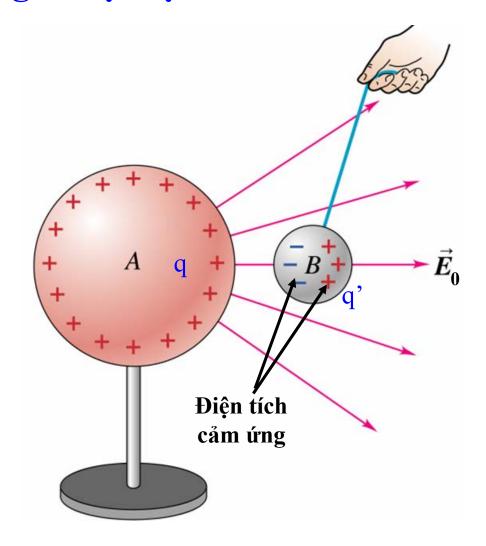
♥ Quá trình phân bố lại các điện tích tự do trong vật dẫn dưới tác dụng của điện trường ngoài ⇒ hiện tượng cảm ứng điện tĩnh = điện hưởng.



Hiện tượng điện hưởng

Điện hưởng một phần

- Chỉ một phần đường sức của A đi qua B con một phần đi ra vô cùng.
- Diện tích cảm ứng có độ lớn nhỏ hơn độ lớn điện tích trên vật mang điện.



Hiện tượng điện hưởng

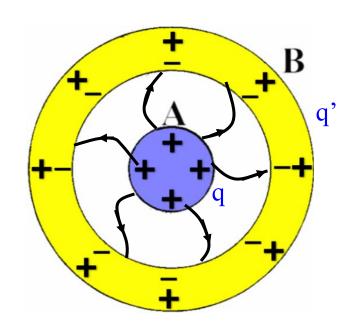
Điện hưởng toàn phần

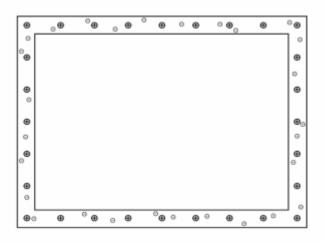
- Vật dẫn B bao kín vật mang điện A ⇒ tất cả đường sức của A đều tận cùng trên vật dẫn B.
- Điện tích cảm ứng có độ lớn bằng độ lớn điện tích trên vật mang điện.

$$|q'| = |q|$$

Màn chắn tĩnh điện

Vật dẫn cân bằng tĩnh điện rỗng đặt trong trường ngoài \Rightarrow tái phân bố điện tích \Rightarrow $E_{trong} = 0$.

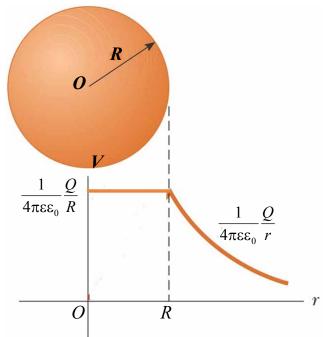




Điện dung vật dẫn cô lập

$$\frac{1}{k} = \frac{Q}{V} = const = C \implies Q = C.V$$

➡ Định nghĩa: Điện dung C của một vật dẫn cô lập là đại lượng vật lý có giá trị bằng trị số điện tích mà vật dẫn tích được khi điện thế của nó bằng một đơn vị điện thế.



 $\$ C đặc trưng cho khả năng tích điện của vật dẫn

Don vị điện dung: Fara (F), theo đó: $1F = \frac{1C}{1V}$

Với quả cầu tích điện đặt trong chân không, có: $C = \frac{Q}{V} = 4\pi\epsilon_0 R$ Nếu C = 1 $F \Rightarrow R = \frac{C}{4\pi\epsilon_0} = \frac{1}{4.3,14.8,86.10^{-12}} = 9.10^9 (m)$

Vì thế, trong kỹ thuật điện và điện tử thường sử dụng đơn vị:

$$1 \mu F = 10^{-6} F$$
; $1 nF = 10^{-9} F$ và $1 pF = 10^{-12} F$

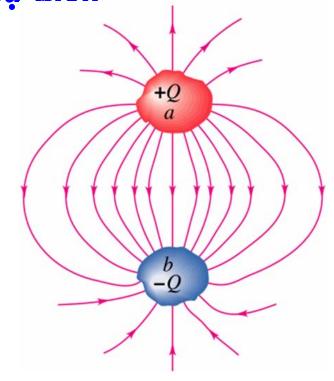
Tụ điện

- F Hệ 2 vật dẫn cô lập ở điều kiện hưởng ứng điện toàn phần
- ™ Mỗi vật dẫn là một bản cực của tụ điện, có điện tích +Q và -Q (ở trên bề mặt), điện thế +V và -V.
- ➡ Hiệu điện thế giữa 2 bản cực:

$$V_1 - V_2 = U$$

Điện dung tụ điện

- Thiện dung C của tụ: $C = \frac{Q}{V_1 V_2} = \frac{Q}{U}$
- Fara là điện dung của một tụ điện khi có điện lượng 1 Coulomb thì hiệu điện thế giữa 2 bản cực bằng 1 volt



Điện dung tụ điện

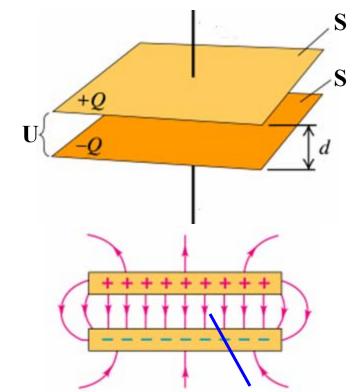
Tụ điện phẳng

- $\begin{tabular}{l} \begin{tabular}{l} \begin{tabu$

Điện dung C của tụ:
$$C = \frac{Q}{V_1 - V_2} = \frac{Q}{U}$$

Với: $U = E.d$ và $E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0 \varepsilon} = \frac{Q}{\varepsilon_0 \varepsilon S}$ $C = \frac{Q}{U} = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon S}{d}$

 $\label{eq:sum} \begin{tabular}{l} Ψ Muốn tăng C \\ \hline \begin{tabular}{l} -Tăng S \Rightarrow nhược điểm: kích thước lớn \\ - Giảm d \Rightarrow nhược điểm: U tăng <math>\rightarrow$ phóng điện đánh thủng

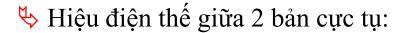


Điện trường đều

Điện dung tụ điện

Tụ điện cầu

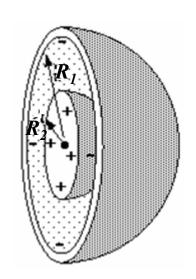
 \ref{Phi} Hệ 2 bản mặt cầu kim loại đồng tâm, bán kính R_1 và R_2 ($R_1 > R_2$), điện tích Q, -Q và điện thế V_1 , V_2 .

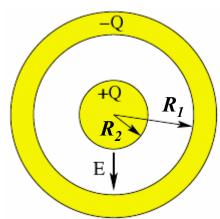


$$U = V_1 - V_2 = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 \varepsilon} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) = \frac{Q(R_1 - R_2)}{4\pi\varepsilon_0 \varepsilon R_1 R_2}$$

➡ Điện dung C của tụ:

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{4\pi\varepsilon_0 \varepsilon R_1 R_2}{\left(R_1 - R_2\right)}$$





Điện dung tụ điện

Tụ điện trụ

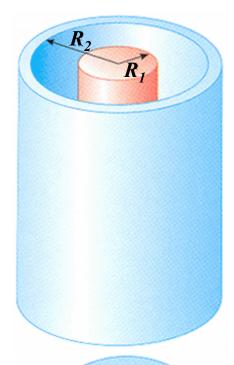
Fig. Hệ 2 mặt trụ kim loại đồng trục, bán kính R_1 và R_2 ($R_1 < R_2$), độ cao l ($l >> R_1$ và R_2), điện tích Q, -Q và điện thế V_1 , V_2 .

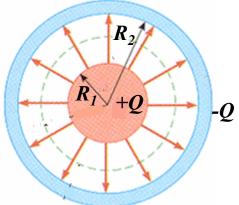
➡ Hiệu điện thế giữa 2 bản cực tụ:

$$U = V_1 - V_2 = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 \varepsilon l} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

➡ Điện dung C của tụ:

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{2\pi\varepsilon_0 \varepsilon l}{\ln \frac{R_2}{R_1}}$$





Năng lượng tương tác của một hệ điện tích điểm

Hệ 2 điện tích điểm

Thế năng của q_2 trong trường gây bởi q_1 :

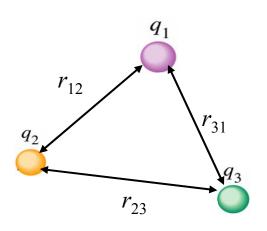
$$W = \frac{1}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r} = \frac{1}{2} q_1 \left(\frac{q_2}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0 r} \right) + \frac{1}{2} q_2 \left(\frac{q_1}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0 r} \right)$$

$$V_1$$

Thờng lượng hệ 2 điện tích điểm: $W = \frac{1}{2}q_1V_1 + \frac{1}{2}q_2V_2$

Hệ 3 điện tích điểm

$$\begin{split} W &= W_{12} + W_{23} + W_{31} = \frac{1}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \left(\frac{q_1q_2}{r_{12}} + \frac{q_2q_3}{r_{23}} + \frac{q_3q_1}{r_{31}} \right) = \\ &= \frac{1}{2} q_1 \left[\frac{1}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \left(\frac{q_2}{r_{21}} + \frac{q_3}{r_{31}} \right) \right] + \frac{1}{2} q_2 \left[\frac{1}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \left(\frac{q_3}{r_{32}} + \frac{q_1}{r_{12}} \right) \right] + \\ &+ \frac{1}{2} q_3 \left[\frac{1}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \left(\frac{q_1}{r_{12}} + \frac{q_2}{r_{22}} \right) \right] = \frac{1}{2} \left(q_1V_1 + q_2V_2 + q_3V_3 \right) \end{split}$$



Năng lượng tương tác của một hệ điện tích điểm

Thờng lượng hệ n điện tích điểm: $W = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} q_i V_i$

Năng lượng của một vật dẫn tích điện cô lập

Thăng lượng vật dẫn: $W = \frac{1}{2} \int V dq = \frac{1}{2} V \int dq = \frac{1}{2} V Q = \frac{1}{2} CV^2$

vì
$$Q = C.V \Rightarrow W = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C}$$

Năng lượng điện của một hệ vật dẫn tích điện

 $\mbox{\em \color \mathbb{P}}$ Hệ vật dẫn có điện tích $Q_1,\,Q_2,\ldots,\,Q_n$ và điện thế $V_1,\,V_2,\ldots,\,V_n$

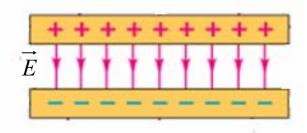
Thờng lượng hệ vật dẫn:
$$W = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} Q_i V_i$$

Năng lượng điện trường

Tụ điện phẳng

Năng lượng điện của tụ điện phẳng:

$$W = \frac{1}{2}QV_1 + \left(-\frac{1}{2}QV_2\right) = \frac{1}{2}Q(V_1 - V_2) = \frac{1}{2}QU = \frac{1}{2}CU^2$$



Măng lượng điện trường giữa 2 bản cực:

$$W = \frac{1}{2}CU^2 = \left(\frac{1}{2}\varepsilon\varepsilon_0 E^2\right)A.d$$

Với: A.d = thể tích không gian giữa 2 bản tụ

Năng lượng điện trường chứa trong một đơn vị thể tích của không gian điện trường:

$$w_E = \frac{1}{2} \varepsilon \varepsilon_0 E^2$$
 hay: $w_E = \frac{1}{2} E \cdot \varepsilon_0 E = \frac{1}{2} E D$

Năng lượng điện trường

Điện trường bất kỳ

- Thia nhỏ không gian có điện trường thành vô số các phần tử thể tích dV vô cùng nhỏ sao cho điện trường E trong dV được coi là đều.
- $\$ Năng lượng điện trường trong một thể tích dV:

$$dW = w.dV = \frac{1}{2}\vec{E}\vec{D}.dV$$

Năng lượng điện trường trong cả thể tích không gian điện trường:

$$W = \int dW = \int_{V} \frac{1}{2} \vec{E} \vec{D} . dV$$